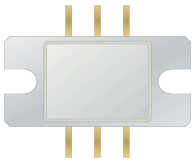
2000–6000 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (대표값)

LCT-2000-6000-PO45p51T · 2000–6000 MHz · GaN 내부 정합 전력 트랜지스터.



RF 전기 특성표의 규격값: 참고 출력 전력 45.51 dBm (대표값); 전력 이득 19.51 dB (대표값); 드레인 효율 39.82 % (대표값) @ 6000 MHz. RF 측정 조건: TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm.

MH_400F6BA

6000 MHz에서 응용 회로의 대표 참고 데이터입니다.

패키지 외형 치수: 18.03 × 8.7 × 2.49 mm.

RF 특성

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	2000	-	6000	MHz
참고 출력 전력 [1]	-	-	45.51	-	dBm
전력 이득 [1]	-	-	19.51	-	dB
드레인 효율 [1]	ηD	-	39.82	-	%

[1] f = 6000 MHz

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
드레인 동작 전압	-	-	-	-	28	V
드레인 정지 전류	-	-	-	-	1.3	A
게이트 문턱 전압 [1]	-	-4	-2.8	-1	-	V
정지 게이트 바이어스 [2]	-	-	-2.6	-	-	V
드레인-소스 항복 전압 [3]	-	90	-	-	-	V
드레인-소스 누설 전류 [4]	-	-	-	0.0104	-	A

[1] VDS = 28 V; ID = 10.4 mA
[2] VDS = 28 V; ID = 1300 mA
[3] VGS = -10 V; ID = 10.4 mA
[4] VGS = -10 V; VDS = 90 V

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	-	-	-	30	V
게이트 바이어스 하한	-	-10	-	-	V
보관 온도	-	-65	-	150	°C
최대 채널 온도	-	-	-	225	°C
최대 게이트 바이어스	-	-	-	2	V
최대 게이트 순방향 전류	-	-	-	0.0104	A

패키지 외형 치수

항목	값	단위
패키지 외형 치수	18.03 × 8.7 × 2.49	mm

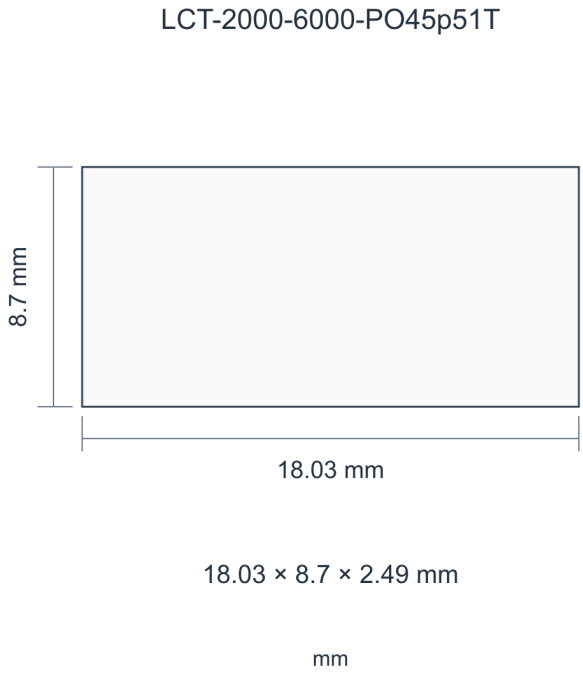
현재 발행 기록 · 1.3 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.2.

통합 설계 안내

MH_400F6BA 6000 MHz에서 응용 회로의 대표 참고 데이터입니다.

기구 외형도

일부 치수를 mm 단위로 표시한 참고 도면입니다. 장착에는 전체 설치 도면을 사용하십시오.



문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.